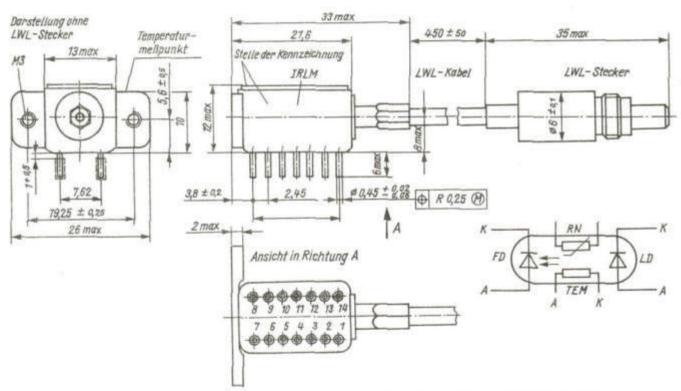
## mikroelektronik

# Information



VQ 150

Infrarotlasermodul (IRIM) im Metallgehäuse mit einem Lichtwellenleiter (LWL)-Kabel mit LWL-Stecker. Das IRIM enthält eine GaAs-Laserdiode (LD) als Sender, eine Si-Fotodiode (FD) als Monitordiode, ein Feltierelement (TEMM) zur Temperierung der inneren Wärmesenke und einen Thermistor (RN) zur Temperaturmessung an der inneren Wärmesenke.



Messe:

25 g, einschließlich

LWL-Kabel und LWL-Stecker

Standard: TGL 42942

		milw	maw	
Dauerstrahlungs-		man	max	
leistung	$\Phi_{\mathrm{LL}}$		2	mW
Spitzenstrahlungs-				
leistung periodisch	Φ <sub>LLRM</sub>		3	mW
Durchlaß-				
gleichstrom <sup>1)</sup>	IF		190	mA.
Spitzendurchlaßstrom				
periodisch1)	IPRM		200	mA
Sperrgleichspannung	$\mathbf{u}_{\mathrm{R}}$		1	A
Spitzensperrspannung	$\mathbf{u}_{\mathrm{RMM}}$		1	٧
PD				
Sperrgleichspannung	$u_R$		15	V
TEMM				
Spannung	UT		4,5	v
Isolationswiderstand	rIS	50		kSZ
zwischen beliebigen				
unabhängigen Anschlüs	sen			
(Strombegrenzung 100	μA)			
Flanschtemperatur	3 cmax		50	°C
Kennwerte & = 5	50 °C			
LD				
Daniel Street				
Dauerstrahlungs-				
Dauerstrahlungs- leistung				
	$\Phi_{\mathrm{LL}}$	1,5		mW
leistung	$\Phi_{\mathrm{LL}}$	1,5		mW
leistung bei Ip % 150 mA	$\Phi_{\mathrm{LL}}$	1,5		mW
leistung bei I <sub>p</sub> ≤ 150 mÅ  Spitzenstrahlungs- leistung		1,5		mW mW
leistung bei I <sub>p</sub> ≤ 150 mÅ Spitzenstrahlungs-				
leistung bei I <sub>p</sub> ≤ 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei I <sub>FRM</sub> ≤ 160 mA  Schwellstrom (Gleichstrom) ♣ = 30	$\Phi_{\text{LLRM}}$			
leistung bei I <sub>p</sub> ≤ 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei I <sub>FRM</sub> ≤ 160 mA  Schwellstrom	Φ <sub>LLRM</sub>		120	
leistung bei I <sub>p</sub> ≤ 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei I <sub>PRM</sub> ≤ 160 mA  Schwellstrom (Gleichstrom) ♣ = 30 ♣ = 30 °C	$\Phi_{\text{LLRM}}$		120	mW
leistung bei Ip \( \) 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei IpRM \( \) 160 mA  Schwellstrom (Gleichstrom) \( \) = 30  \( \) = 30 \( \) C  Durchlaßgleich-	Φ <sub>LLRM</sub>		120	mW
leistung bei I <sub>p</sub> ≤ 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei I <sub>FRM</sub> ≤ 160 mA  Schwellstrom (Gleichstrom) ♣ = 30	Φ <sub>LLRM</sub>		120	mW
leistung bei Ip \( \) 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei IpRM \( \) 160 mA  Schwellstrom (Gleichstrom) \( \) = 30  \( \) = 30 \( \) C  Durchlaßgleich- spannung	Φ <sub>LLRM</sub>			mW mA
leistung bei Ip ≤ 150 mA  Spitzenstrahlungs- leistung bei IpRM ≤ 160 mA  Schwellstrom (Gleichstrom) % = 30 % = 30 °C  Durchlaßgleich- spannung bei Ф <sub>IL</sub> = 1,5 mW	Φ <sub>LLRM</sub>			mW mA

Wellenlänge der				
max. Emission	A <sub>p</sub>	820	860	nm
Spektrale Strahlungs-	19/2			
bandbreite	Δ×0,5		4	nm
<u>PD</u>				
Potostrom	Ip	50		$\mu \mathtt{A}$
Dunkelsperrstrom				
bei $U_R = 10 \text{ V}$	IRO		20	nA
Fotostrom-Gleichlauf-				
verhältnis <sup>2)</sup>				
bei $\theta_{c} = 30$ °C	KIP	0,63	1,5	
TEMM				
Peltierstrom	$\mathtt{I}_{\mathfrak{T}}$		0,75	A
Peltierspannung	UT		4	A
RN				
Thermistorwiderstand				
bei $\theta_{\rm C}$ = 25 °C	$R_{\overline{M}}$	9,9	10,1	K2

<sup>1)</sup> Ip bzw. IpRM darf nur bis  $\Phi_{\rm LL}$  = 2 mW bzw.  $\Phi_{\rm LLRM}$  = 3 mW geregelt werden

<sup>2)</sup>  $K_{IP} = \frac{I_{p}(t)}{I_{p}(t=0)} t = \frac{1}{\lambda B}$ 

#### Anwendungsvorschriften

Die BE sind für den Betrieb mit Kühlkörper mit einem kleinem Wärmewiderstand (R<sub>th</sub> = 2.3 K/W für Flansch bis Umgebungstemperatur) vorgesehen. Eine Reinigung des Kühlflansches vor dem Anschrauben ist erforderlich, die Ebenheit des Kühlflansches (zwischen den Gewindelöchern) beträgt C,1 mm. Ein Betrieb des Lasers ohne angeschlossenen Peltierkühler ist nicht zulässig. Die Einbaulage ist beliebig.

Die Kontaktierung der elektrischen Anschlüsse erfolgt über einseitig kaschierte, nicht durchkontaktierte Leiterplatten, Mindestdicke: 1,0mm bzw. mittels geeigneter Steckfassungen. Zum Einsatz kommende Steckfassungen milssen vom BE-Hersteller freigegeben werden. Mehrmaliges Stecken reduziert die Lötbarkeit der Anschlüsse. Permanente Zug- oder Druckkräfte sowie Biegungen und Torsionen der Anschlüsse sind nicht zulässig. Ist die Leiterplatte mit dem Kühlkörper verbunden, besteht relativ leicht die Gefahr, daß solche Kräfte bei der Befestigung auftreten. In diesen Fällen muß das Bauelement erst an den Kühlkörper geschraubt werden, bevor die Anschlüsse gelötet werden.

Mechanische Beanspruchung des Lichtwellenleiters am Bauelementenanschluß und am Stecker: Der Biegersdius muß mindestens 30 mm betragen. Torsions- und Zugbeanspruchung des LWL sind nach TGL 55 141 einzuhalten. Der LWL ist in Abständen von 150 bis 200 mm jeweils zu fixieren.

#### Löten

Für die VQ 150 ist nur die Kolbenlötung zulässig. Die Temperatur der Lötkolbenspitze muß 280 °C - 20 K betragen. Die maximale Lötzeit beträgt 2,5 s. Die Lötstelle muß mindestens 1 mm von der Austrittsstelle der Anschlüsse aus dem Gehäuse entfernt sein. An die Austrittsstelle der Anschlüsse darf kein Flußmittel gebracht werden. Der äußere Isolationswiderstand der Austrittsstelle muß 1 GOhm sein, damit nicht insbesondere der Dunkelstrom der Fotodiode durch Oberflächenkriechströme erhöht wird. Das verwendete Flußmittel darf nicht korrodierend wirken. Zulässig sind z.B. die Flußmittel SW 31 und SW 32 nach TGL 14 907.

#### Reinigung

Das Beuelement ist mit Äthanol oder Isopropsnol waschbar. Die Reinigung des Lichtleitersteckers ist mit einem weichen, nicht fasernden Tuch und reinem Äthanol möglich. Bei der
Reinigung des Bauelemente-Körpers ist darauf
zu achten, daß kein Waschmittel zwischen Bauelemente-Körper und Anschlußleiterplatte gelangt. Bei nicht restloser Austrocknung des
Waschmittels würde der Oberflächenisolations-

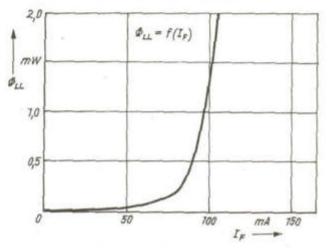
widerstand der Anschlüsse unzulässig verringert werden.

#### Hinweise für den elektrischen Betrieb und den Arbeitsschutz

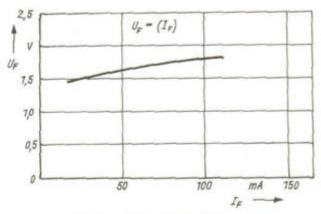
Achtung! Bei Betrieb des Lasermoduls tritt unsichtbare Laserstrahlung aus. Nach TGL 30 064 ist die VQ 150 in die Sicherheitsklasse 3B eingeordnet. Es gelten die allgemeinen Betriebsund Sicherheitsbedingungen (TGL 30 690) für Halbleiterlaser.

Aus Sicherheitsgründen (Augenschäden) ist die Austrittsfläche des LWL am Stecker bei Betrieb nur mit einer IR-Kamera zu betrachten. Die technischen Daten bleiben nur gültig, wenn keine Überlastung durch Impulsspitzen aus der Stromversorgung o.ä. auftreten. Solche Impulsspitzen, auch im ns-Bereich, können bei Einund Ausschaltvorgängen in Stromversorgungen oder aus dem Netz an die Diode gelangen. Die

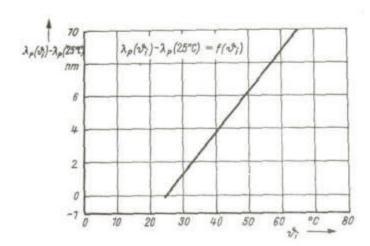
Ansteuerung sollte unter diesen Gesichtspunkten ausgelegt werden. Durch elektrostatische Aufladungen können ebenfalls solche Impulse antstehen. Deshalb sind bei der VQ 150 die für MOS-Bauelemente üblichen Handhabungsvorschriften einzuhalten. Kurzschlußbrücke zwischen Pin 9 und 10 im ausgebauten Zustand!



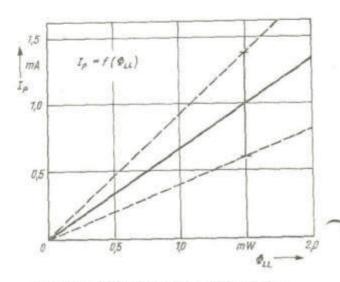
Abhängigkeit der Dauerleistungsstrahlung vom Flußstrom



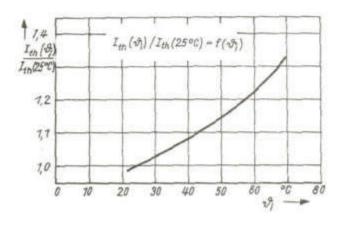
Abhängigkeit der Flußspannung vom Flußstrom



Abhängigkeit der max. Emissionswellenlänge  $\lambda_{\rm p}$  von der Temperatur, bezogen auf  $\lambda_{\rm p}$  bei 25 °C



Mittlere Abhängigkeit des Stromes der Potodiode von der Dauerstrahlungsleistung



Abhängigkeit des Schwellstromes Ith von der Temperatur der inneren Wärmesenke, bezogen auf Ith bei  $\vartheta_1 = 25$  °C

Änderungen vorbehalten! Redektionsschluß Juli 87





veb werk für fernsehelektronik berlin im veb kombinet mikroelektronik

DDR-1160 Berlin, Ostendstraße Telefon: 6 35 27 41, Telex: 112 007

Neue Telefonnummer: 63 830

### elektronik export.import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Telex: BLN 114721 elei